

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE HYPERFREQUENCE

MICROWAVE CERAMIC CHIP CAPACITORS

SOMMAIRE

Généralités sur les chips céramique multicouches hyperfréquence	p. 127
Feuilles particulières sur les chips céramique multicouches hyper.	p. 130
Généralités sur les condensateurs céramique monocouches hyper.	p. 132
Feuilles particulières sur les condensateurs céramique monocouches hyperfréquence	p. 134
Généralités sur les condensateurs céramique de puissance	p. 137
Feuille particulière sur les condensateurs céramique de puissance	p. 138

SUMMARY

General presentation of microwave ceramic multilayer chip	p. 127
Microwave ceramic multilayer chip capacitors data sheets	p. 130
General presentation of microwave single layer ceramic capa.	p. 132
Microwave ceramic single layer chip capacitors data sheets	p. 134
General presentation of power ceramic capacitors	p. 137
Power ceramic capacitors data sheet	p. 138

REPERTOIRE

Appellation normalisée selon add. 6 de juin 87	Appel. comm.	Ancienne appel. comm.	Coefficient de température	Gamme de tensions	Gamme de capacités	Gamme de tolérances	Page
NFC 93133 Standard type	Comm. type	Former std. designation	Temperature coefficient	Voltage range	Capacitance range	Tolerances range	Page

Chips céramique multicouches hyperfréquence



CEA 1	HC	CEC 23	$+100 \pm 30$ ppm	50 V - 500 V	0,1 pF - 1000 pF	$\pm 0,1$ pF $\pm 0,25$ pF $\pm 0,5$ pF ± 1 pF ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 %	130
CEA 11	HC-R	CEC 33					
CEA 2	HD	CEC 24					
CEA 22	HD-R	CEC 34					
CEA 3	HB	CEC 21					
CEA 33	HB-R	CEC 31					
CEA 4	HA	CEC 22					
CEA 44	HA-R	CEC 32					



CEC 35	TNC		0 ± 30 ppm	50 V - 500 V	0,1 pF - 5600 pF	$\pm 0,1$ pF $\pm 0,25$ pF $\pm 0,5$ pF ± 1 pF ± 1 % ± 2 % ± 5 % ± 10 %	131
CEC 45	TNC-R						
CEC 36	TND						
CEC 46	TND-R						
	CHF 1						
CEC 37	CHF 2						
CEC 47	CHF 2-R						
CEC 38	CHF 12						
CEC 48	CHF 12-R						
CEC 39	CHF 4						
CEC 49	CHF 4-R						



Chips céramique monocouches hyperfréquence

MCH 111

Microwave ceramic single layer chip capacitors

100 V 0,05 pF - 4700 pF

134



MCH 112
MCH 113



Condensateurs céramique de puissance

SPT 519

0 ± 30 ppm 550 V - 6300 V 10 pF - 5600 pF ± 5 % ± 10 % 138



CAW 54 à / to 65

100 ± 30 ppm 1000 V - 3600 V 1 pF - 15 nF ± 5 % ± 10 % 139

CEW 54 à / to 65

0 ± 30 ppm 1000 V - 3600 V 1 pF - 15 nF ± 5 % ± 10 % 139

CNW 32

X7R 100 V - 300 V 10 nF - 1 μ F ± 10 % ± 20 % 140

GENERALITES

A des fréquences inférieures à la fréquence de résonance (voir fig. 73), un condensateur peut être considéré comme une capacité pure C_s en série avec une résistance équivalente ESR, les deux éléments étant shuntés par une résistance pure R_p . La résistance série ESR de faible valeur, généralement inférieure à 1Ω (voir fig. 68 et 69), est prépondérante en utilisation hyperfréquence par rapport à la résistance R_p de valeur très élevée ($> 10^6 \text{ M}\Omega$).

Cette résistance série équivalente est essentiellement composée de :

- la résistance série intrinsèque des électrodes et des terminaisons. Elle est très faible tout au plus égale à quelques dizaines de milliohms,
- la résistance due aux pertes de la structure atomique du matériau.

En effet, les pertes dans les condensateurs apparaissent d'abord dans le diélectrique, milieu où l'énergie est stockée et transférée. Le facteur de qualité Q , inverse de $Tg \delta$ dont des valeurs typiques sont présentées sur fig. 66 et 67, est défini comme étant le rapport de la quantité d'énergie stockée à celle dissipée par cycle.

Les matériaux diélectriques contiennent des atomes porteurs de charges qui sont déplacés de leur position d'équilibre par un champ électrique. La plupart de ces matériaux contiennent des molécules dipolaires, naturellement polarisées. Sous l'influence d'un champ électrique extérieur, les dipôles s'alignent par rotation, dans la direction du champ. Quand celui-ci est alternatif, la fréquence de rotation des molécules est proportionnelle à celle du champ. Ces mouvements se traduisent par une dissipation thermique d'une partie de l'énergie mise en jeu. Le pourcentage de dissipation est, en général, proportionnel à la puissance et à la fréquence de l'énergie hyperfréquence appliquée.

Pour un comportement convenable du matériau diélectrique en haute fréquence, il faut donc que, dans une structure de degré de symétrie le plus élevé possible, ces atomes soient libres d'évoluer facilement sous l'influence du champ électrique autour de leur position d'équilibre, c'est-à-dire, en particulier, que le taux de "remplissage" de la maille soit faible.

Ces conditions sont parfaitement remplies par le matériau spécifique développé par EUROFARAD et dont les caractéristiques diélectriques intrinsèques sont les suivantes (à la température ambiante) :

- 1 MHz $\epsilon / \epsilon_0 = 18$, $Q \geq 50\,000$
- 1 GHz $\epsilon / \epsilon_0 = 18$, $Q \geq 10\,000$

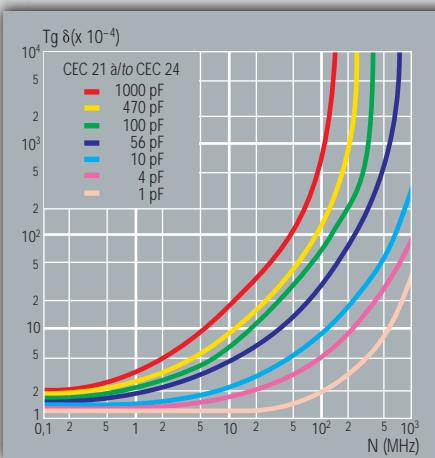


Fig. 66 Tangente de l'angle de pertes en fonction de la fréquence.
Loss angle tangent change vs frequency.

GENERAL INFORMATION

At frequencies below the self-resonant frequency (see figure 73), a capacitor can be considered as a pure capacitor C_s with an equivalent series resistor R_S , both elements being shunted by a pure resistor R_p . Low series resistance of R_S , usually below 1 ohm (see figures 68 and 69) is prevailing the very high resistance of R_p (above $10^6 \text{ M}\Omega$) in microwave applications.

Equivalent series resistance (R_p) is essentially comprised of :

- the intrinsic series resistance of electrodes and terminations, which is a few tens of milliohms maximum,
- the resistance inherent to material atomic structure losses.

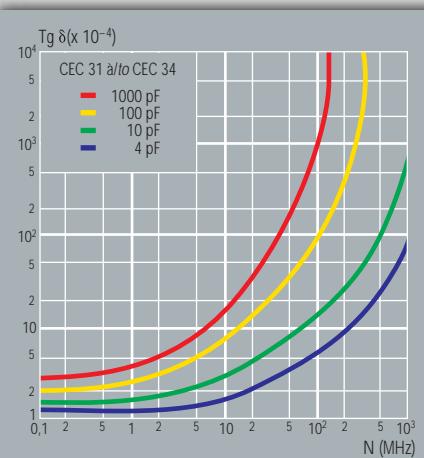


Fig. 67 Tangente de l'angle de pertes en fonction de la fréquence.
Loss angle tangent change vs frequency.

Dissipation in capacitors first occurs in the dielectric where the energy is stored and transferred. Quality factor Q , in inverse proportion to $Tg \delta$ (see figures 66 and 67 for typical values), is determined by the ratio of stored energy to dissipated energy per cycle.

Dielectric materials contain ionized atoms which are displaced from their equilibrium position by the effect of an electrical field.

Most of these materials include dipole molecules that are biased by nature. Under the effect of an external electrical field, the dipoles come to align with the electrical field in a rotary motion. When submitted to an alternating external field, the rotation frequency of the molecules is proportional to the field frequency. These motions usually result in the dissipation of a portion of the energy involved. Dissipation factor is normally proportional to the power and frequency of the microwave energy applied.

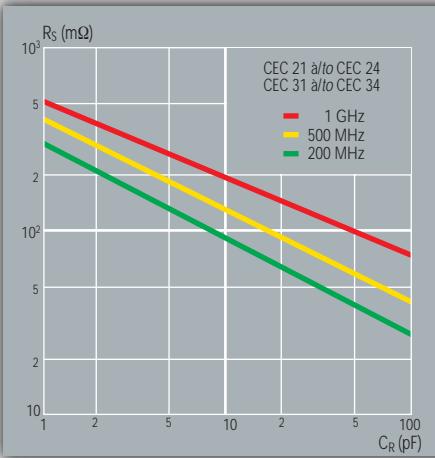


Fig. 68 Résistance série équivalente en fonction de la capacité.
Equivalent series resistance vs capacitance.

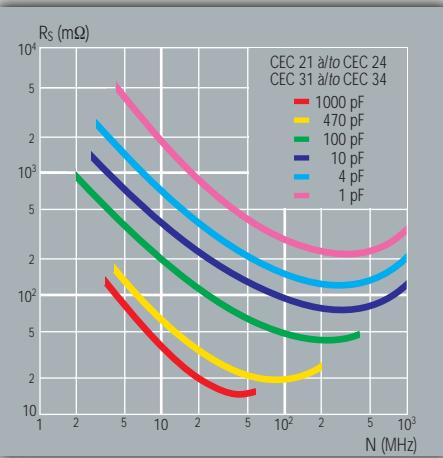


Fig. 69 Résistance série équivalente en fonction de la fréquence.
Equivalent series resistance vs frequency.

For proper HF performance of the dielectric material, the atoms must be able to move freely around their equilibrium position in the most symmetrical possible structure under the effect of the electrical field, i.e. mesh density must be low.

These conditions are perfectly fulfilled with the specific raw material used by EUROFARAD. This compound has the following dielectric characteristics at ambient temperature :

- at 1 MHz $\epsilon / \epsilon_0 = 18$, $Q \geq 50\,000$
- at 1 GHz $\epsilon / \epsilon_0 = 18$, $Q \geq 10\,000$

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE MULTICOUCHES HYPERFREQUENCE

MICROWAVE MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS

Dans un condensateur, le facteur de qualité sera légèrement plus faible en raison des résistances séries introduites par les électrodes et les connexions ainsi que par la structure polycristalline et polyphasée du matériau.

Pour une taille et une tension de service déterminée, ce facteur décroît :

- a) à une fréquence donnée, lorsque la valeur de la capacité augmente (fig. 70),
- b) à une valeur de capacité donnée, lorsque la fréquence augmente (fig. 71).

Ces figures donnent l'évolution de ce paramètre en fonction de la fréquence et pour différentes valeurs de capacité.

En fait, les pertes propres aux matériaux diélectriques et métalliques sont peu affectées.

Pour la plus grande partie, ces courbes traduisent l'influence du terme selfique $jL\omega$ -lié aux déplacements de charges dans les électrodes- qui vient se soustraire au terme capacitif $-j/c\omega$ et proportionnellement faire croître l'importance du terme résistif.

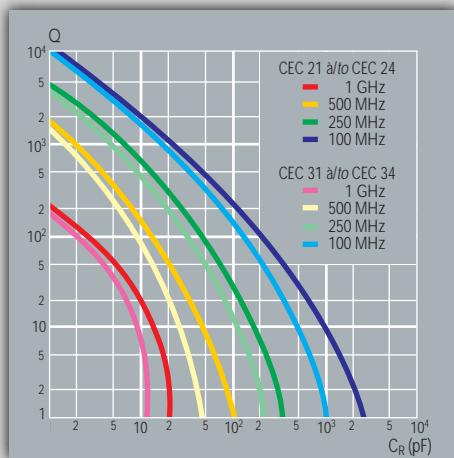


Fig. 70 Facteur de qualité en fonction de la capacité.
Quality factor vs capacitance.

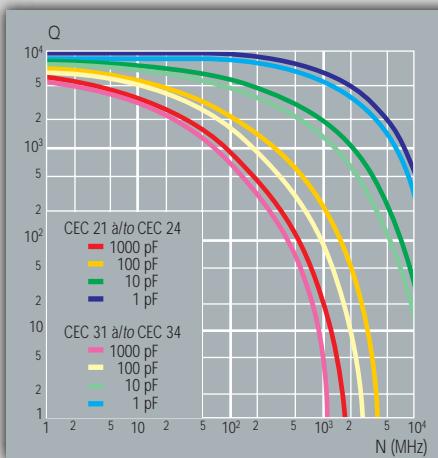


Fig. 71 Facteur de qualité en fonction de la fréquence.
Quality factor vs frequency.

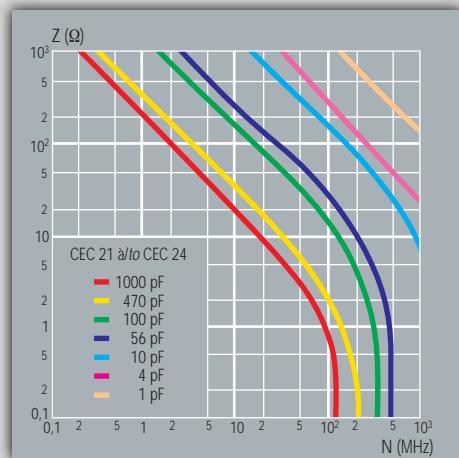


Fig. 72 Impédance en fonction de la fréquence.
Impedance vs frequency.

Les valeurs de l'angle de pertes étant faibles, les puissances réactives admissibles sont élevées. Les valeurs mesurées sont indiquées sur les fig. 74 et 75.

En réalité ces valeurs correspondent à une élévation arbitrairement choisie de 45°C, mesurée dans l'air dans un calorimètre, sans possibilité d'échange autre que la convection naturelle. En pratique, le report sur un circuit qui assurera le rôle de drain thermique ou, dans les cas extrêmes, l'utilisation de radiateurs, permettent de passer des courants efficaces beaucoup plus importants.

Des calculs spécifiques à toute configuration de montage seront effectués à la demande par les laboratoires EUROFARAD.

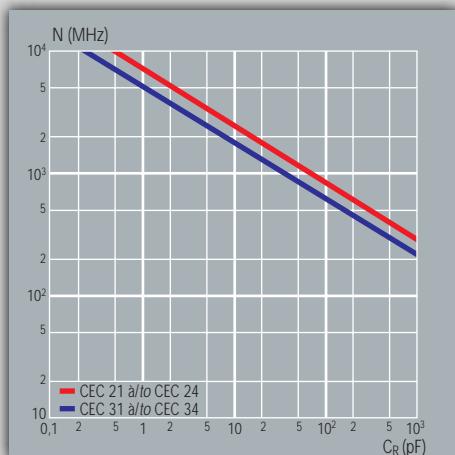


Fig. 73 Fréquence de résonance en fonction de la capacité.
Resonance frequency change vs capacitance.

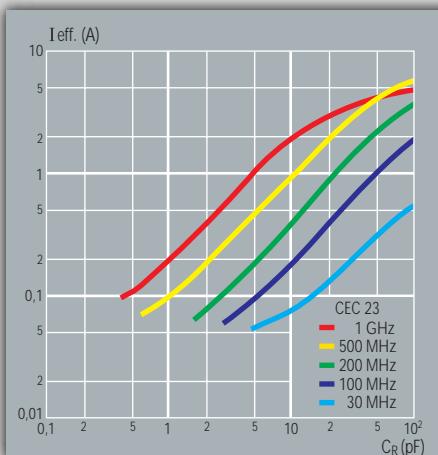


Fig. 74 Intensité admissible en fonction de la fréquence.
Permissible RMS current vs frequency.

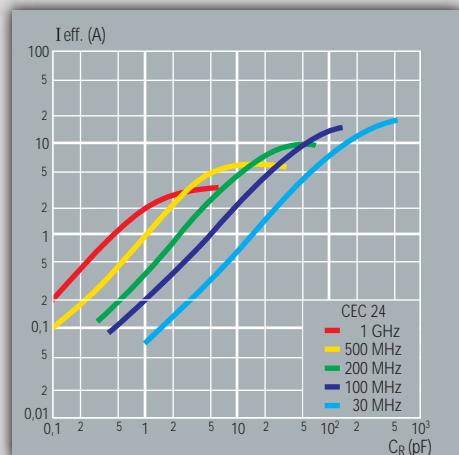


Fig. 75 Intensité admissible en fonction de la fréquence.
Permissible RMS current vs frequency.

Puissance dissipée / Dissipated power : 2 W

Température du condensateur / Capacitor temperature : 125°C

Drain thermique / Thermal drain : 50°C

Résistance thermique du montage / Thermal mounting resistance : 10°C / W

CARACTERISTIQUES EN HAUTES FREQUENCES

HIGH FREQUENCY CHARACTERISTICS

Tableau 19 : Facteur de Qualité Q pour condensateurs hyperfréquences.

Table 19 : Quality factor Q for microwave capacitors.

Gamme de capacités Capacitance range	Fréquence de mesures Test frequency	Facteur de surtension Q typique Surge voltage factor typical Q		
		CHF 1 CHF 2 - CHF 2-R CHF 4 - CHF 4-R CHF12 - CHF12-R	TNC - TNC-R TND - TND-R THD - THD-R	HB - HB-R HA - HA-R HC - HC-R HD - HD-R
0,1 pF à/10 10 pF	500 MHz	75	100	150
> 10 pF à/10 22 pF	400 MHz	75	100	150
> 22 pF à/10 47 pF	200 MHz	75	100	150
> 47 pF à/10 100 pF	100 MHz	75	100	150
> 100 pF à/10 470 pF	50 MHz	75	100	150
> 470 pF à/10 1 000 pF	10 MHz	75	100	150

Au-dessus de 1 000 pF, la tangente δ , mesurée à 1 MHz, est inférieure à $15 \cdot 10^{-4}$.

Above 1 000 pF tangent δ at 1 MHz is lower than $15 \cdot 10^{-4}$.

Les ondes électromagnétiques ne se propagent pas, en général, dans un espace illimité mais sont, au contraire, retenues à l'intérieur d'un certain nombre de frontières physiques. La matière dirige ou modifie la réflexion et la réfraction des champs. Les ondes incidentes, réfléchies et réfractées sont liées par les conditions aux limites.

Le rapport de l'amplitude réfléchie à l'amplitude incidente est le coefficient de réflexion et le rapport de l'amplitude transmise à l'amplitude incidente est le coefficient de transmission.

Dans le cas d'une incidence normale, les ondes, incidentes et réfléchies, se superposent et forment, par interférence, des ondes stationnaires.

Le taux d'ondes stationnaires (TOS) est le rapport entre l'amplitude maximale (ventre) et l'amplitude minimale (nœuds) de cette onde.

Un condensateur, en raison de ses paramètres capacitifs, inductifs, résistifs combinés est assimilable à un quadripôle. Un quadripôle est une partie de réseau, comprise entre deux paires de bornes d'accès, qui est isolée électriquement et magnétiquement du reste du réseau, sauf par l'intermédiaire de ses bornes d'accès.

Electromagnetic waves propagation is not unlimited. It is usually confined within a number of physical limits. The material controls or modifies the reflection and refraction of the fields, and incident, sky and refracted waves propagation is dependent on the conditions prevailing at the limits.

Reflected to incident amplitude ratio determines the reflection factor, and transmitted to incident amplitude ratio determines the transmission factor.

In case of a normal incidence, incident and sky waves superpose each other and form standing waves due to interfering effects.

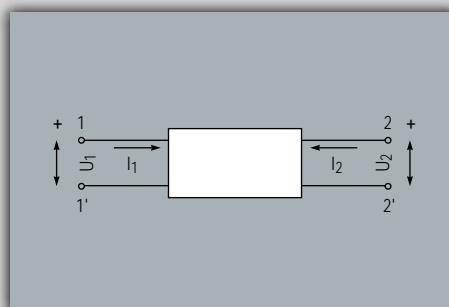
The standing wave ratio (SWR) is determined by the maximum to minimum (peak to valley) amplitude ratio of the wave considered.

Considering combined capacitance, inductance and resistance characteristics of a capacitor, it is similar to a quadripole. A quadripole is a network section comprised between two pairs of terminals that is electrically and magnetically insulated from the rest of the network, except via the terminals.

Ce quadripôle reçoit de l'énergie de ses bornes 1 et 1' et transmet cette énergie au reste du réseau à ses bornes de sortie 2 et 2'.

Les paramètres S constituent la matrice de distribution dans laquelle :

- S1-1' et S2-2' sont les coefficients de réflexions à l'entrée et à la sortie,
- S2-1 exprime le facteur de transmission directe,
- S1-2 est le facteur de transmission inverse. Il est égal à S2-1 lorsque le quadripôle est passif et nul lorsque les grandeurs de sortie ne réagissent pas sur les grandeurs d'entrée.



The quadripole receives energy via input terminals 1 and 1'. This energy is transmitted via output terminals 2 and 2'.

S characteristics make up the system matrix where :

- S1-1' and S2-2' are the input and output reflection factor respectively,
- S2-1 is the direct transmission factor,
- S1-2 is the reverse transmission factor - reverse factor is equal to S2-1 when the quadripole is idle and null when output voltage is non-reactive to input voltage.

Sur demande, **EUROFARAD** pourra fournir les valeurs de ces paramètres en fonction du composant et de la configuration de montage retenue.

Information on these parameters according to the component and mounting configuration is available on request.

HC - HD HA - HB - THD

HYPERFREQUENCE MICROWAVE

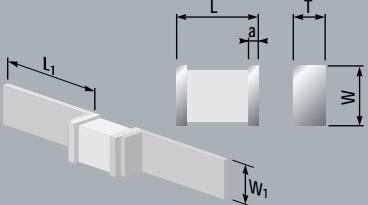


Conformes aux spécifications des normes

CECC 32101 et NFC 93133

In accordance with the specifications of

CECC 32101 and NFC 93133 standards



L, W, T pour chips étamé (option E) : + 0,5 mm
L, W, T for tinned chips (option E) : + 0,5 mm

Diélectrique	Céramique hyperfréquence
Technologie	Chips multicouches terminaisons soudables ou sorties par rubans soudables
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Température d'utilisation	
HC - HD - HB - HA	- 55°C + 125°C
THD	- 55°C + 175°C
Coef. de température	+ 100 ± 30.10⁻⁶/°C
Tension nominale U _{RC}	50 V - 500 V
Tension de tenue	2,5 U _{RC}
Tangente δ à 1 MHz	$\leq 0,5 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 5 \cdot 10^{-4}$
C _R > 50 pF	$\geq 10^6 M\Omega$
R _i à 20°C C _R ≤ 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
C _R > 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
R _i à 125°C C _R ≤ 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
C _R > 470 pF	$\geq 10^4 M\Omega$
R _i à 175°C THD	$\geq 10^5 M\Omega$
Facteur de Qualité Q	voir p. 129 table 19
MARQUAGE	
MARQUAGE	Sur demande
Valeur de capacité	En clair ou en code

Dielectric	Microwave ceramic
Technology	Multilayer chips weldable terminations or weldables tabs
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Operating temperature	
HC - HD - HB - HA	- 55°C + 125°C
THD	- 55°C + 175°C
Temperature coef.	+ 100 ± 30.10⁻⁶/°C
Rated voltage U _{RC}	50 V - 500 V
Test voltage	2,5 U _{RC}
Tangent δ at 1 MHz	$\leq 0,5 \left(\frac{150}{C_R} + 7 \right) \cdot 10^{-4}$
C _R ≤ 50 pF	$\leq 5 \cdot 10^{-4}$
C _R > 50 pF	$\geq 10^6 M\Omega$
R _i at 20°C C _R ≤ 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
C _R > 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
R _i at 125°C C _R ≤ 470 pF	$\geq 10^5 M\Omega$
C _R > 470 pF	$\geq 10^4 M\Omega$
R _i at 175°C THD	$\geq 10^5 M\Omega$
Quality Factor Q	see p. 129 table 19
MARKING	
MARKING	On request
Capacitance value	Clear or coded

CONDENSATEURS CHIPS CÉRAMIQUE MULTICOUCHES

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS

Rubans	Modèle normalisé / Standard model					Code des valeurs de C _R Capacitance value coded	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance
	CEA 1 CEA 11	CEA 2 CEA 22	CEA 3 CEA 33	CEA 4 CEA 44	Ancienne appellation commerciale / Former type		
Rubans	CEC 23	CEC 24	CEC 21	CEC 22	Appellation commerciale / Commercial type		
Rubans	CEC 33	CEC 34	CEC 31	CEC 32	Dimensions / Dimensions (mm)		
	HC HC-R	HD HD-R	HB HB-R	HA HA-R	THD THD-R		
L	1,4 ± 0,25	2,8 ± 0,4	2 ± 0,3	3,2 ± 0,4	2,8 ± 0,4		
W	1,4 ± 0,25	2,8 ± 0,4	1,25 ± 0,2	2,5 ± 0,3	2,8 ± 0,4		
T max.	1,4	2,6	1,25	1,7	2,5		
a	0,2 / 0,4	0,2 / 0,4	0,2 / 0,6	0,2 / 0,75	0,2 / 0,75		
L ₁	6,3	6,3	10	10	8		
W ₁	1,3 ± 0,2	2,4 ± 0,2	1,3 ± 0,2	2,4 ± 0,2	2,4 ± 0,2		
Tension nominale / Rated voltage							
U _{RC} (V)	50 63 100 200	50 63 100 200 300 500	50 63 100	50 63 100	100 300 500	E12 E24 E48 E96	
0,1 pF						OR1	
0,2						OR2	
0,3						OR3	
0,4						OR4	
0,5						OR5	
0,6						OR6	
0,7						OR7	
0,8						OR8	
0,9						OR9	
1						109	
1,2						129	
1,5						159	
1,8						189	
2,2						229	
2,7						279	
3,3						339	
3,9						399	
4,7						479	
5,6						569	
6,8						689	
8,2						829	
10						100	
12						120	
15						150	
18						180	
22						220	
27						270	
33						330	
39						390	
47						470	
56						560	
68						680	
82						820	
100						101	
120						121	
150						151	
180						181	
220						221	
270						271	
330						331	
390						391	
470						471	
560						561	
680						681	
820						821	
1000						102	
± 10 % (K)							
± 5 % (G)							
± 2 % (G)							
± 1 % (F)							

Exemple de codification à la commande / How to order

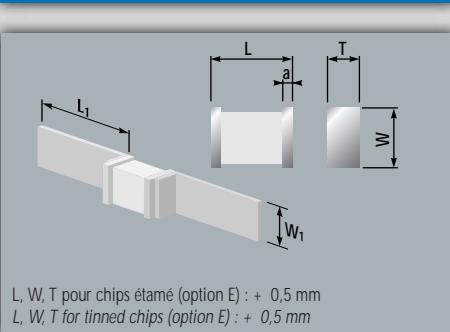
Appellation commerciale Commercial type	Terminaisons (voir page 10) Terminations (see page 10)	Tension nominale Rated voltage	Capacité Capacitance			Tolérance Tolerance		
			HC	--	10 pF	10 %	100 V	

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE MULTICOUCHES

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS

TNC - TND - CHF 1 CHF 2 - CHF 4 - CHF 12

Modèle normalisé / Standard model										Code des valeurs de C_R Capacitance value coded			
Rubans	CEC 35 CEC 45	CEC 36 CEC 46	CEC 37 CEC 47	CEC 39 CEC 49	CEC 38 CEC 48	Appellation commerciale / Commercial type					Code des valeurs de C_R Capacitance value coded		
Rubans	TNC TNC-R	TND TND-R	CHF 1	CHF 2 CHF 2-R	CHF 4 CHF 4-R	CHF 12 CHF 12-R	Dimensions / Dimensions (mm)					Code des valeurs de C_R Capacitance value coded	
L	1,4 ± 0,25	2,8 ± 0,4	1,25 ± 0,2	2 ± 0,3	3,2 ± 0,4	3,2 ± 0,4	L	W	T	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance	Code des valeurs de C_R Capacitance value coded		
W	1,4 ± 0,25	2,8 ± 0,4	1 ± 0,2	1,25 ± 0,2	2,5 ± 0,3	1,6 ± 0,2	a	L ₁	T	Tolérance on Capacitance			
T max.	1,4	2,6	1	1,25	1,7	1,25	a	0,2 / 0,4	0,2 / 0,4	Conformes aux spécifications des normes CECC 32101 et NF C 93133 In accordance with the specifications of CECC 32101 and NF C 93133 standards			
L ₁	6,3	6,3	10	10	10	10	W ₁	1,3 ± 0,2	2,4 ± 0,2	1,3 ± 0,2			
W ₁	1,3 ± 0,2	2,4 ± 0,2	1,3 ± 0,2	2,4 ± 0,2	1,3 ± 0,2	1,3 ± 0,2	Tension nominale / Rated voltage						
U _{RC} (V)	50 63 100 200 50 63 100 200 300 500 50 63 100 50 63 100 50 63 100 50 63 100	E12 E24 E48 E96	Dimensions / Dimensions (mm)										
0,1 pF	OR1	OR2	OR3	OR4	OR5	OR6	OR7	OR8	OR9	109	129	159	189
0,2										229	279	339	399
0,3										479	569	689	829
0,4										100	120	150	180
0,5										220	270	330	390
0,6										470	560	680	820
0,7										101	121	151	181
0,8										221	271	331	391
0,9										471	561	681	821
1										102	122	152	182
1,2										222	272	332	392
1,5										472	512	562	
1,8													
2,2													
2,7													
3,3													
3,9													
4,7													
5,6													
6,8													
8,2													
10													
12													
15													
18													
22													
27													
33													
39													
47													
56													
68													
82													
100													
120													
150													
180													
220													
270													
330													
390													
470													
560													
680													
820													
1000													
1200													
1500													
1800													
2200													
2700													
3300													
3900													
4700													
5100													
5600													



Diélectrique	Céramique hyperfréquence
Technologie	Chips multicoques terminaisons soudables ou sorties par rubans soudables
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Température d'utilisation	- 55°C + 125°C
Coef. de température	Classe CG
Tension nominale U _{RC}	50 V - 500 V
Tension de tenue	2,5 U _{RC}
Ri à 20°C	C _R ≤ 470 pF ≥ 10 ⁶ MΩ
	C _R > 470 pF ≥ 10 ⁵ MΩ
Ri à 125°C	C _R ≤ 470 pF ≥ 10 ⁵ MΩ
	C _R > 470 pF ≥ 10 ⁴ MΩ
Facteur de Qualité Q	voir p. 129 tableau 19
MARQUAGE	
Sur demande	
Valeur de capacité	En clair ou en code

Dielectric	Microwave ceramic
Technology	Multilayer chips weldable terminations or weldables tabs
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Operating temperature	- 55°C + 125°C
Temperature coef.	Class CG
Rated voltage U _{RC}	50 V - 500 V
Test voltage	2,5 U _{RC}
Ri at 20°C	C _R ≤ 470 pF ≥ 10 ⁶ MΩ
	C _R > 470 pF ≥ 10 ⁵ MΩ
Ri at 125°C	C _R ≤ 470 pF ≥ 10 ⁵ MΩ
	C _R > 470 pF ≥ 10 ⁴ MΩ
Quality Factor Q	see p. 129 table 19
MARKING	
On request	
Capacitance value	Clear or coded

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	Terminaisons (voir page 10) Terminations (see page 10)	Tension nominale Rated voltage
TNC	--	10 pF 0,1 pF 100 V
		Capacité Capacitance Tolérance Tolerance

CONDENSATEURS CERAMIQUE MONOCOUCHES HYPERFREQUENCE

MICROWAVE SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS

GENERALITES

MCH 111 - MCH 112 - MCH 113

Ces condensateurs sont constitués d'une plaque céramique métallisée sur ses deux grandes faces opposées.

Leurs dimensions standard correspondent aux largeurs de lignes hyperfréquences de façon à éviter les désadaptations d'impédance liées aux facteurs dimensionnels (autres tailles réalisables sur demande).

Leurs configurations conduisent à des inductances très faibles, ce qui leur confère, pour une valeur de capacité donnée, une fréquence de résonance (voir fig. 76) nettement supérieure à celle des "multicouches" et permet donc de repousser d'autant les fréquences de travail des équipements.

Une métallisation standard (TiW-Ni-Au) suffixe D assure un comportement électrique satisfaisant jusqu'à 50 GHz et permet tous les modes de report :

- brasure (1),
- colle conductrice (2),
- thermocompression (3),
- soudure thermosonique (4),
- soudure électrique (5).

D'autres métallisations sont réalisables (voir tableau 20).

Tableau 20 : Les diverses métallisations disponibles et leurs caractéristiques. *Table 20 : Possible metallizations and their characteristics.*

Codification <i>Code metallization</i>	Nature des terminaisons <i>Terminations types</i>	Epaisseur du dépôt (typique) <i>Typical Thickness</i>	Technologie <i>Technology</i>	Reports possibles <i>Possible connections</i>
A	Or (Au)	15 µm	Couche épaisse <i>Thick film</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5
C	Or sur chrome	2,5 µm	Couche mince <i>Thin film</i>	2 - 3 - 4 - 5
D	TiW-Ni-Au	5 µm	Couche mince <i>Thin film</i>	1 - 2 - 3 - 4 - 5
W	TiW-Au	2,5 µm	Couche mince	2 - 3 - 4 - 5

Certains modèles adaptés à des applications spécifiques présentent l'une des métallisations partagées en plusieurs secteurs (MCH 112, MCH 113 par exemple).

Des modèles à rubans sont également disponibles.

GENERAL INFORMATION

MCH 111 - MCH 112 - MCH 113

These are made of a ceramic substrate metallized on its two opposite widest surfaces.

Their standard dimensions fit to microwave line widths so as to prevent any impedance mismatch due to dimensional factors (other sizes manufactured on request).

Their configurations lead to very low inductances. So, for a given capacitance value, their resonance frequency (figure 76) is much higher than the resonance frequency of multilayer ceramic capacitors, thus enabling to achieve as much higher operating frequencies.

Standard metallization (TiW-Ni-Au) suffix D make them suitable for operating frequencies up

to 50 GHz and compatible with all types of connections :

- Soldering (1),
- Conductive epoxy bonding (2),
- Thermocompression (3),
- Ultrasonic welding (4),
- Electrical welding (5).

Other metallizations are available (see table 20)

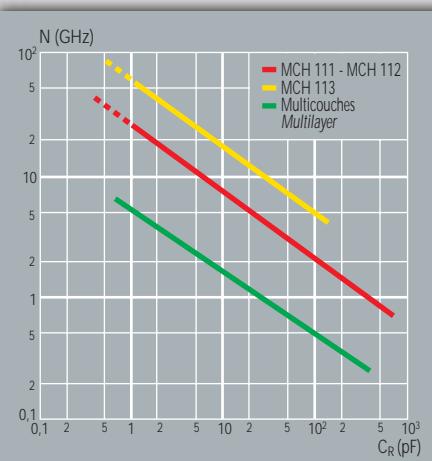


Fig. 76 Fréquence de résonance série.
Resonant series frequency.



Analyseur de réseau (40 GHz)

Network analyser (40 GHz)

CONDENSATEURS CERAMIQUE MONOCOUCHES HYPERFREQUENCE

MICROWAVE SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS

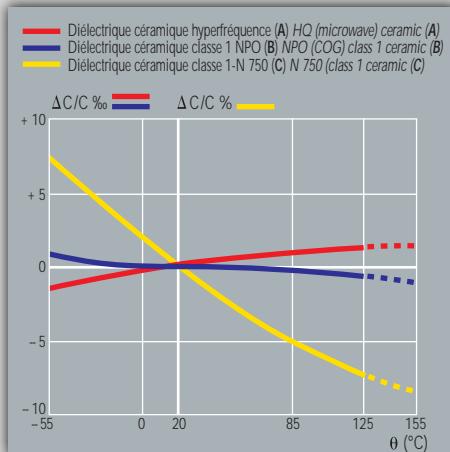


Fig. 77 Variation relative de la capacité en fonction de la température.
Relative capacitance change vs temperature.

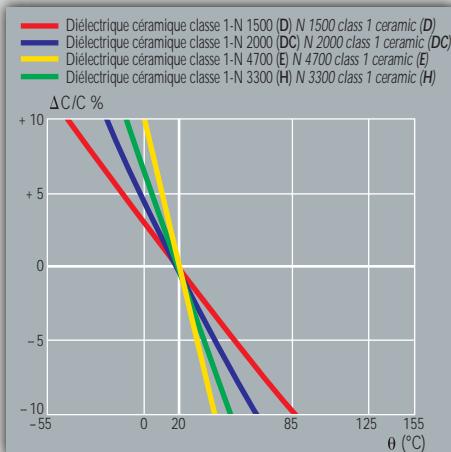


Fig. 78 Variation relative de la capacité en fonction de la température.
Relative capacitance change vs temperature.

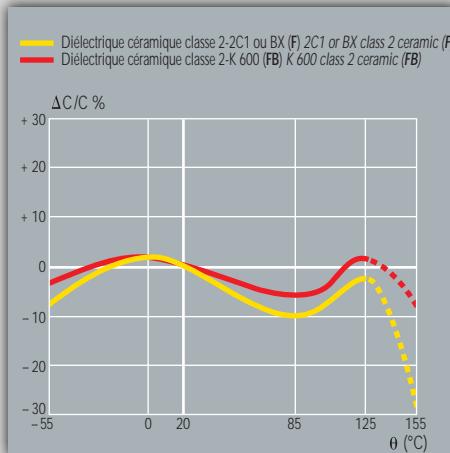


Fig. 79 Variation relative de la capacité en fonction de la température.
Relative capacitance change vs temperature.

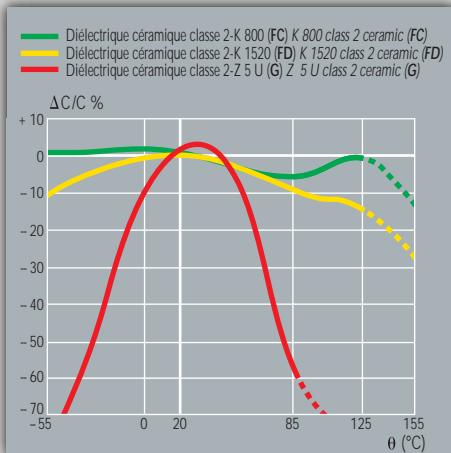


Fig. 80 Variation relative de la capacité en fonction de la température.
Relative capacitance change vs temperature.

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT

De - 55°C à + 125°C : pas de derating sur la tension nominale.

Les condensateurs monocouches **EUFARAD** sont conçus pour répondre aux essais de la norme **MIL C 55681**. Elle inclut les essais suivants en accord avec la norme **MIL STD 202** :

- Endurance à 125°C et 2 fois la tension nominale (méthode 108 variante F),
- Basse pression atmosphérique (méthode 105 variante B),
- Chocs (méthode 213 variante J),
- Vibrations (méthode 204 variante B),
- Chocs thermiques (méthode 107 variante B),
- Immersion (méthode 104 variante B),
- Combiné climatique (méthode 106),
- Soudabilité (méthode 208),
- Robustesse des sorties (méthode 211),
- Brouillard salin (méthode 101 variante B).

ENVIRONMENTAL TESTS

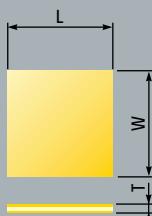
No rated voltage derating from - 55°C to + 125°C.

EUFARAD single layer capacitors are designed to meet the requirements of **MIL C 55681** standard that includes the following tests in accordance with **MIL STD 202** standard :

- Lifecycle test at + 125°C and test voltage = rated voltage x 2 (method 108 variant F),
- Low barometric pressure (method 105 variant B),
- Shocks (method 213 variant J),
- Vibrations (method 204 variant B),
- Thermal shocks (method 107 variant B),
- Immersion (method 104 variant B),
- Moisture resistance (method 106),
- Solderability (method 208),
- Robustness of terminations (method 211),
- Salt spray (method 101 variant B).

MCH 111

**HYPERFREQUENCE
MICROWAVE**



Diélectrique

Céramique
hyperfréquence

Technologie

Chips monocouches
terminaisons or en
couche mince (D)
autres métallisations
nous consulter

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Température d'utilisation (sans derating de tension)	- 55°C + 125°C
Coefficient de température	voir tableau 1
Tension nominale U_{RC}	100 V
Tension de tenue	250 V
Fréquence d'utilisation	≤ 50 GHz
Facteur Q et tangente δ	voir tableau 1
Résistance d'isolation à 25°C	$\geq 100\ 000$ MΩ
Résistance d'isolation à 125°C	$\geq 10\ 000$ MΩ

MARQUAGE Sur conditionnement

Modèle-diélectrique-boîtier	
Capacité - tolérance	
Tension	
Date-code	

Dielectric	Microwave ceramic
Technology	Single layer chip thin film gold terminations (D) other metals or alloys on request

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Operating temperature	
without voltage derating	- 55°C + 125°C
Temperature coefficient	see table 1
Rated voltage U_{RC}	100 V
Test voltage	250 V
Frequency utilisation	≤ 50 GHz
Factor Q and tangent δ	see table 1
Insulation resistance at 25°C	$\geq 100\ 000$ MΩ
Insulation resistance at 125°C	$\geq 10\ 000$ MΩ

MARKING On package	
Model-dielectric-case	
Capacitance - tolerance	
Voltage	
Date-code	

CONDENSATEURS CERAMIQUE MONOCOUCHES

SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS

Diélectrique en code <i>Coded ceramic</i>	Caractéristiques capacité / température K ou / or $\frac{\Delta C}{C}$ <i>Capacitance / temperature characteristics</i>	Tangente et facteur Q <i>Tangent and Q factor</i>
A	Hyperfréquence K = 100 ± 30 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 10000
B	Classe 1 NPO K = 0 ± 30 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 600
C	Classe 1-N 750 K = -750 ± 200 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 600
D	Classe 1-N 1500 K = -1500 ± 250 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 400
DC	Classe 1-N 2000 K = -2000 ± 500 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 250
E	Classe 1-N 4700 K = -4700 ± 1500 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 200
F	Classe 2-2C1 ou BX $\frac{\Delta C}{C} + 10\% - 15\%$	Tg à / to 1 kHz 200.10 ⁻⁴ Q à / to 1 MHz 25
FB	Classe 2-K 600 $\frac{\Delta C}{C} \pm 7,5\%$	Tg à / to 1 kHz 200.10 ⁻⁴ Q à / to 1 MHz 35
FC	Classe 2-K 800 $\frac{\Delta C}{C} \pm 10\%$	Tg à / to 1 kHz 200.10 ⁻⁴ Q à / to 1 MHz 30
FD	Classe 2-K 1520 $\frac{\Delta C}{C} + 5\% - 15\%$	Tg à / to 1 kHz 200.10 ⁻⁴ Q à / to 1 MHz 20
G	Classe 2-Z5U $\frac{\Delta C}{C} + 10\% - 75\%$	Tg à / to 1 kHz 200.10 ⁻⁴ Q à / to 1 MHz 30
H	Classe 1-N 3300 K = -3300 ± 1500 ppm / °C	Q à / to 1 MHz 200

Tableau 1 / Table 1

* Terminaisons <i>Terminations</i>	
A	Au
C	Cr-Au
D	TiW-Ni-Au
W	TiW-Au

** Modèles à rubans (voir tableau 4) <i>Ribbon models (see table 4)</i>	
E	Monoruban <i>Single lead</i>
F	2 rubans radiaux <i>2 radial leads</i>
G	2 rubans axiaux <i>2 axial leads</i>

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale <i>Commercial type</i>	Taille en code <i>(voir tableau 2)</i>	Capacité en code <i>(voir tableau 2)</i>	Tension nominale <i>Rated voltage</i>
MCH111	U	F	100
Diélectrique en code <i>(voir tableau 1)</i>	Tolérance en code <i>(voir tableau 3)</i>		
Coded ceramic <i>(see table 1)</i>	Coded size <i>(see table 3)</i>		

CONDENSATEURS CERAMIQUE MONOCOUCHES

SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS

MCH 111

Tension nominale 100 V_{CC} / Rated voltage 100 V_{DC}

Taille en code Coded size	R	S	T	U	X	Y	Z
	Dimensions / Dimensions (mm)						
Diélectrique en code Coded ceramic	L	0,35 ± 0,05	0,45 ± 0,08	0,64 ± 0,12	0,89 ± 0,12	1,27 ± 0,25	1,78 ± 0,25
	W	0,25 ± 0,05	0,45 ± 0,08	0,64 ± 0,12	0,89 ± 0,12	1,27 ± 0,25	1,78 ± 0,25
	T	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3
A	0,05 pF 0,1 pF	0,05 pF 0,1 pF	0,09 pF 0,2 pF	0,1 pF 0,2 pF	0,2 pF 0,4 pF	0,2 pF 0,8 pF	0,3 pF 0,5 pF
B	0,1 pF 0,5 pF	0,1 pF 0,4 pF	0,2 pF 1 pF	0,2 pF 0,9 pF	0,3 pF 2 pF	0,3 pF 1,5 pF	0,6 pF 3 pF
C	0,3 pF 0,9 pF	0,3 pF 0,6 pF	0,7 pF 2 pF	0,7 pF 1,5 pF	1,3 pF 3,9 pF	1,2 pF 3 pF	2,7 pF 7,5 pF
D	0,5 pF 1,3 pF	0,4 pF 1 pF	1,1 pF 3 pF	1 pF 2 pF	2,2 pF 6,2 pF	1,8 pF 4,3 pF	4,7 pF 12 pF
DC	0,9 pF 2,7 pF	0,9 pF 1,8 pF	1,8 pF 5,1 pF	2 pF 4,3 pF	3,9 pF 12 pF	3,9 pF 7,5 pF	8,2 pF 22 pF
E	1,1 pF 3 pF	1 pF 2 pF	2,4 pF 7,5 pF	2,2 pF 4,7 pF	5,1 pF 12 pF	4,3 pF 8,2 pF	9,1 pF 18 pF
F	6,2 pF 27 pF	3,9 pF 10 pF	15 pF 56 pF	10 pF 27 pF	27 pF 120 pF	18 pF 47 pF	36 pF 100 pF
FB	1,6 pF 4,3 pF	1,3 pF 3 pF	3,9 pF 10 pF	3,3 pF 27 pF	7,5 pF 18 pF	6,2 pF 56 pF	15 pF 36 pF
FC	2,2 pF 7,5 pF	1,5 pF 3,9 pF	5,6 pF 18 pF	3,6 pF 9,1 pF	12 pF 39 pF	6,8 pF 16 pF	20 pF 39 pF
FD	4,3 pF 15 pF	2,4 pF 5,6 pF	10 pF 39 pF	5,6 pF 16 pF	20 pF 75 pF	11 pF 27 pF	39 pF 120 pF
G	24 pF 68 pF	8,2 pF 18 pF	51 pF 150 pF	20 pF 39 pF	100 pF 330 pF	33 pF 68 pF	200 pF 560 pF
H	0,8 pF 2 pF	0,7 pF 1,5 pF	2 pF 5,1 pF	1,5 pF 3,9 pF	3,9 pF 11 pF	3 pF 8,2 pF	7,5 pF 18 pF

Tableau 2 / Table 2

■ Couche mince / Thin film : Métallisation C (Cr-Au) D (TiW-Ni-Au) W (TiW-Au) ■ Couche épaisse / Thick film : Métallisation A (Au)

Tension nominale 100 V_{CC} / Rated voltage 100 V_{DC}

Valeurs de capacité C _R Capacitance value	Capacité en code Coded capacitance	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance					Valeurs de capacité C _R Capacitance value	Capacité en code Coded capacitance	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance					Valeurs de capacité C _R Capacitance value	Capacité en code Coded capacitance	Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance				
		E6	E12	E24	E48	E96			E6	E12	E24	E48	E96			E6	E12	E24	E48	E96
0,05 pF	OR05					*	10 pF	100						270	271					
0,1	OR1						11	110						300	301					
0,2	OR2						12	120						330	331					
0,3	OR3						13	130						360	361					
0,4	OR4						15	150						390	391					
0,5	OR5						16	160						430	431					
0,6	OR6						18	180						470	471					
0,7	OR7						20	200						510	511					
0,8	OR8						22	220						560	561					
0,9	OR9						24	240						620	621					
1	1R0						27	270						680	681					
1,1	1R1						30	300						750	751					
1,2	1R2						33	330						820	821					
1,3	1R3						36	360						910	911					
1,5	1R5						39	390						1000	102					
1,6	1R6						43	430						1100	112					
1,8	1R8						47	470						1200	122					
2	2R0						51	510						1300	132					
2,2	2R2						56	560						1500	152					
2,4	2R4						62	620						1600	162					
2,7	2R7						68	680						1800	182					
3	3R0						75	750						2000	202					
3,3	3R3						82	820						2200	222					
3,6	3R6						91	910						2400	242					
3,9	3R9						100	101						2700	272					
4,3	4R3						110	111						3000	302					
4,7	4R7						120	121						3300	332					
5,1	5R1						130	131						3600	362					
5,6	5R6						150	151						3900	392					
6,2	6R2						160	161						4300	432					
6,8	6R8						180	181						4700	472					
7,5	7R5						200	201												
8,2	8R2						220	221												
9,1	9R1						240	241												
Tolérances en fonction des diélectriques Tolerances versus dielectrics		A	B	C	D	DC	E	F	FB	FC	FD	G	H	A	B	C	D	DC	E	F

Tableau 3 / Table 3

* Tolérance particulière ± 0,05 pF (code Q) / Particular tolerance ± 0,05 pF (code Q)

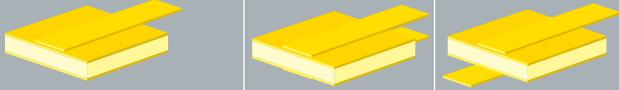
Modèles à rubans / Ribbon models				Dimensions du ruban / Ribbon dimensions										
Code Coded	E	F*	G	Taille Size	R	S	T	U	X	Y	Z			
Monoruban Single lead	2 rubans radiaux 2 radial leads	2 rubans axiaux 2 axial leads		L min. (mm)	Sur demande particulière On specific request	7								
				I (mm)		0,4		1						
				T (μm)		50								
				Ruban en argent pur (autres métaux sur demande) / Pure Ag ribbon (others metals on request)										

Tableau 4 / Table 4

* Peut être formé en beam lead / May be formed in beam lead

Formats spécifiques / Specifics size															
	P	RM	RP	RR	SM	TM	UM	W	WM	XH	XM	XZ	ZM	TP	RV
L	0,93 ± 0,05	0,49 ± 0,15	0,25 ± 0,03	0,38 ± 0,05	0,53 ± 0,05	0,73 ± 0,05	0,83 ± 0,05	0,73 ± 0,05	0,93 ± 0,05	*	1,03 ± 0,1	2,53 ± 0,1	2,54 + 0 - 0,25	0,79 + 0 - 0,07	0,38 + 0 - 0,07
h	0,83 ± 0,05	0,38 ± 0,02	0,25 ± 0,03	0,38 ± 0,05	0,53 ± 0,05	0,73 ± 0,05	0,83 ± 0,05	0,43 ± 0,05	0,43 ± 0,05	1,33 ± 0,02	1,03 ± 0,1	1,28 ± 0,1	2,54 + 0,51 - 0,25	0,79 + 0,15 - 0,07	0,5 max.
e	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3		0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3	0,1 / 0,3

Tableau 5 / Table 5

* Dimension à préciser à la commande / To be precised on order

Autres formats possibles sur demande. Consulter notre Service Commercial. Other sizes available on request. Please consult our Sales Department.

CONDENSATEURS MONOCOUCHES MULTICAPACITES



SINGLE LAYER CAPACITORS MULTICAPACITANCE

Spécifications sur demande
Specifications available on request

CONDENSATEURS CERAMIQUE DE PUISSANCE

POWER CERAMIC CAPACITORS

GENERALITES

SPT 519

Ces condensateurs à diélectrique céramique et sorties par rubans d'argent sont des composants haute tension et fort courant qui permettent de travailler avec des pertes réduites sous une très forte puissance volumique.

La technologie de fabrication, comparable à celle de tous les condensateurs céramique multicouches, combine des électrodes en métal noble et une céramique particulière à base de $MgO-Ti-O_2$, céramique à faibles pertes diélectriques et de porosité réduite qui assure à l'ensemble une auto-encapsulation hermétique.

Sans altération de fiabilité, ces condensateurs peuvent être utilisés avec des courants, par unité de volume, environ doubles de ceux permis par les autres condensateurs RF. En outre, leur petite taille et leur architecture ne leur confèrent qu'une très faible auto-inductance permettant de s'affranchir de la plupart des phénomènes de résonance. Ils se présentent en trois boîtiers qui couvrent une gamme de 10 pF à 5 600 pF avec une tension nominale pouvant atteindre 6 300 volts pour une puissance réactive de 35 kVar.

La céramique utilisée ne présente que des dérives insignifiantes sous des contraintes extrêmes de température, temps, tension, courant ou fréquence, ce qui fait de ces condensateurs les composants adaptés à une utilisation d'accord ou d'adaptation d'impédance forte puissance et fort courant.

CONDITIONS DE MONTAGE :

- Distance entre corps et point de soudure : ≥ 3 mm
- Température de soudage : $\leq 260^\circ\text{C}$

CONDITIONS D'UTILISATION :

- Pour une utilisation de $+ 25^\circ\text{C}$ à $+ 125^\circ\text{C}$
Réduire I_{eff} et U_{RC} : $- 0,16\% / ^\circ\text{C}$
Réduire P_q : $- 0,4\% / ^\circ\text{C}$

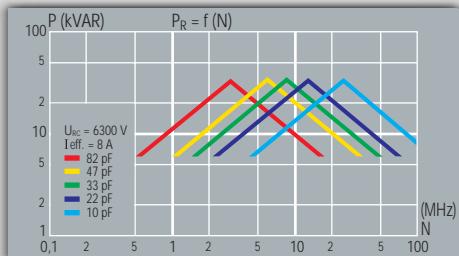


Fig. 81 Puissance réactive maximale pour $C_R = 10$ pF à 82 pF.
Maximum reactive power for $C_R = 10$ pF to 82 pF.

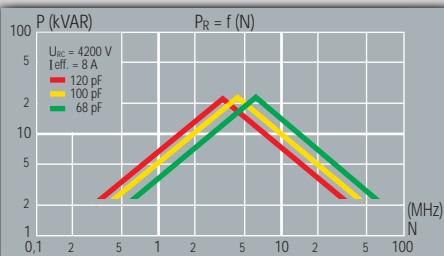


Fig. 82 Puissance réactive maximale pour $C_R = 68$ pF à 120 pF.
Maximum reactive power for $C_R = 68$ pF to 120 pF.

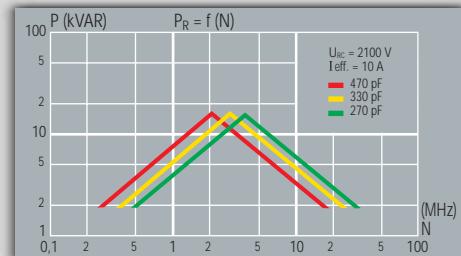


Fig. 83 Puissance réactive maximale pour $C_R = 270$ pF à 470 pF.
Maximum reactive power for $C_R = 270$ pF to 470 pF.

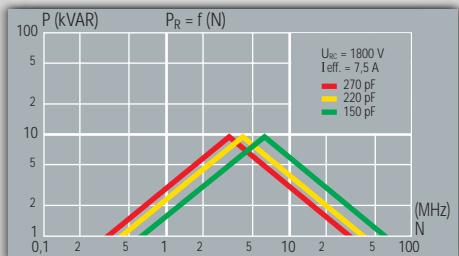


Fig. 84 Puissance réactive max. pour $C_R = 150$ pF à 270 pF.
Max. reactive power for $C_R = 150$ pF to 270 pF.

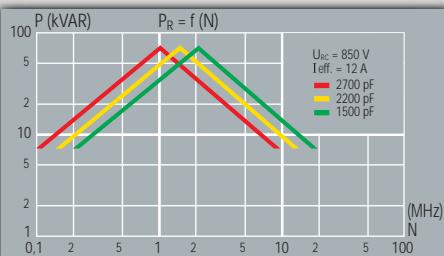


Fig. 85 Puissance réactive max. pour $C_R = 1500$ pF à 2 700 pF.
Max. reactive power for $C_R = 1500$ pF to 2 700 pF.

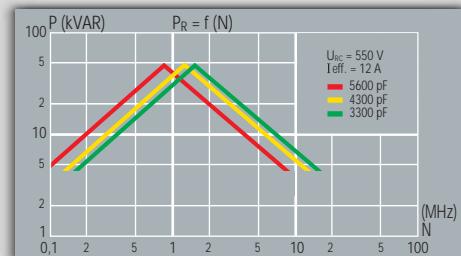


Fig. 86 Puissance réactive max. pour $C_R = 3 300$ pF à 5 600 pF.
Max. reactive power for $C_R = 3 300$ pF to 5 600 pF.

CAW 54 - 55 - 65 – CEW 54 - 55 - 65

Ils prolongent la gamme des SPT 519 par de nouveaux formats et une forte diversité de terminaisons soudables compatibles avec les différentes méthodes de report utilisées.

CNW 32

Utilisant un diélectrique de classe 2, ce modèle d'adresse aux tensions d'utilisation les plus faibles, lorsque les puissances dissipables par effet Joule peuvent être importantes. Il présente la même diversité de terminaisons soudables, adaptées aux différentes techniques de report, que les CAW et CEW 54 - 55 - 65.

POWER CERAMIC CAPACITORS

GENERAL INFORMATION

SPT 519

These multilayer ceramic capacitors fitted out with silver ribbons are high voltage and high current components capable to operate under very high volumic power with low losses.

The manufacturing process, comparable to the process used for all multilayer ceramic capacitors, is based on the use of rare metal electrodes and a special ceramic based on $MgO-Ti-O_2$. This ceramic features low dielectric losses and low porosity with inherently hermetic self-encapsulation capability.

Their current handling capability per volume unit is approximately twice the capability of RF type capacitors without reliability alteration. In addition, their small size and architecture result in a very low self-inductance enabling to get rid of most of resonance phenomena. Three different sizes are available covering capacitance requirements in the 10 pF to 5 600 pF range with a rated voltage up to 6 300 V and a reactive power of 35 kVar.

The ceramic used features insignificant drifts under extreme operating temperature, time, voltage current or frequency conditions, making these capacitors perfectly suited to such applications as tuning or impedance match at high power and high current.

MOUNTING CONDITIONS :

- Distance between body and soldering point : ≥ 3 mm
- Soldering temperature : $\leq 260^\circ\text{C}$

CONDITIONS OF USE :

- For use between 25°C to $+ 125^\circ\text{C}$
Reduce I_{rms} and U_{RC} : $- 0,16\% / ^\circ\text{C}$
Reduce P_q : $- 0,4\% / ^\circ\text{C}$

CAW 54 - 55 - 65 – CEW 54 - 55 - 65

An extension of the SPT 519 range with new outlines and a large diversity of solderable terminals compatible with the various methods currently used.

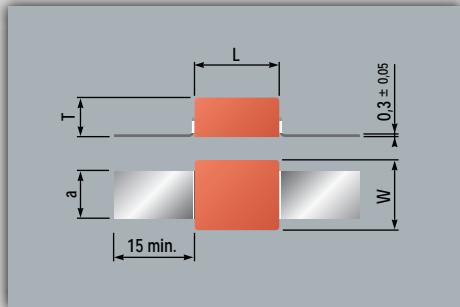
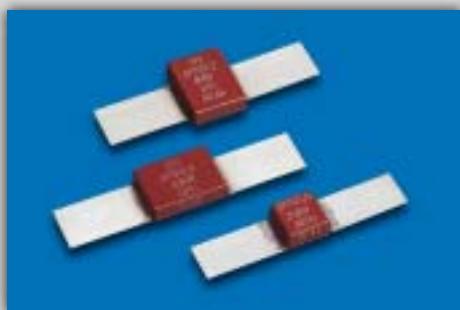
CNW 32

Using a class 2 dielectric, this model is used for low voltage applications where the dissipation by Joule effect is high. The same range of soldering terminals as the CAW and CEW 54 - 55 - 65 range is available.

SPT 519

CONDENSATEURS CÉRAMIQUE DE PUISSANCE

POWER CERAMIC CAPACITORS



Diélectrique	Céramique classe 1
Technologie	Chips multicouches vernis - Sorties par rubans argentés
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES	
Température d'utilisation	- 55°C + 125°C
Coefficient de température	
$C_R > 18 \text{ pF}$	$0 \pm 30 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C}$
$C_R \leq 18 \text{ pF}$	$100 \pm 30 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C}$
Tension nominale U_{RC}	550 V - 6 300 V
Tension de tenue	2 U_{RC}
Tangente δ à 1 MHz	
$C_R < 1000 \text{ pF}$	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tangente δ à 1 kHz	
$C_R \geq 1000 \text{ pF}$	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolement	
à 20°C sous 500 V _{CC}	$\geq 50000 \text{ M}\Omega$
MARQUAGE	
Modèle	
Capacité	
Tolérance	
Tension	
Date-code	

Dielectric	Ceramic class 1
Technology	Varnished multilayer chips with silver ribbon leads
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Operating temperature	- 55°C + 125°C
Temperature coefficient	
$C_R > 18 \text{ pF}$	$0 \pm 30 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C}$
$C_R \leq 18 \text{ pF}$	$100 \pm 30 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C}$
Rated voltage U_{RC}	550 V - 6 300 V
Test voltage	2 U_{RC}
Tangent δ at 1 MHz	
$C_R < 1000 \text{ pF}$	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tangent δ at 1 kHz	
$C_R \geq 1000 \text{ pF}$	$\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance	
at 20°C under 500 V _{DC}	$\geq 50000 \text{ M}\Omega$
MARKING	
Model	
Capacitance	
Tolerance	
Voltage	
Date-code	

	Modèle normalisé / Standard model												Tolérances sur capacité Tolerance on capacitance	
	SPT 519-1				SPT 519-2				SPT 519-3					
	Dimensions / Dimensions (mm)													
L max.	11				13				15,5					
W max.	10				16				13					
T max.	6,5				7				7					
a ± 0,1	7,5				9				9					
	U_{RC} U_{DC} (V) (1)	I eff. I_{RMS} (A) (2)	Pq (kVar) (3)	Z_0^* (Ω) (4)	U_{RC} U_{DC} (V) (1)	I eff. I_{RMS} (A) (2)	Pq (kVar) (3)	Z_0^* (Ω) (4)	U_{RC} U_{DC} (V) (1)	I eff. I_{RMS} (A) (2)	Pq (kVar) (3)	Z_0^* (Ω) (4)		
10 pF													E12 E24	
12														
15														
18														
22														
27														
33														
39														
47	2500	6,5	12	270	6300 **	8	35	555	6300 **	8	35	555		
56														
68														
82														
100														
120														
150														
180														
220														
270														
330														
390														
470														
560														
680	800	9	5	63	1300	12	11	75	1300	12	11	75		
820														
1000														
1200														
1500														
1800														
2200														
2700														
3300														
3900														
4700														
5600														

(1) Tension nominale U_{RC} ($V_{CC} + V$ crête)

(1) Rated voltage U_{DC} ($V_{DC} + V$ peak)

(2) Intensité nominale I eff. (A)

(2) Rated current I_{RMS} (A)

(3) Puissance réactive nominale Pq (kVar)

(3) Reactive rated power Pq (kVar)

(4) Impédance limite Z_0 (Ω)

(4) Maximum impedance Z_0 (Ω)

(5) Impédance à la fréquence d'utilisation Z_C (Ω)

(5) Frequency use impedance Z_C (Ω)

* $Z_C > Z_0$ Limitation de la puissance réactive par la tension nominale : $Pq = U_{eff.}^2/Z_C$

* $Z_C > Z_0$ Reactive power limitation by rated voltage : $Pq = U_{eff.}^2/Z_C$

$Z_C < Z_0$ Limitation de la puissance réactive par l'intensité nominale : $Pq = Z_C I_{eff.}^2$

$Z_C < Z_0$ Reactive power limitation by rated current : $Pq = Z_C I_{eff.}^2$

** Tension nominale 6300 V - Tension de tenue 12000 V effectuée dans un fluide isolant

** Rated voltage 6300 V - Test voltage 12000 V to be performed in insulated liquid

Conditions de montage

body to solder point distance : 3 mm

welding temperature : 260°C

welding temperature : 260°C

Conditions d'utilisation

for operation from 25 to 125°C

réduire I eff. et U_{RC} : - 0,16%/ $^{\circ}\text{C}$

reduce I_{RMS} and U_{DC} by - 0,16%/ $^{\circ}\text{C}$

réduire Pq : - 0,4%/ $^{\circ}\text{C}$

reduce Pq by - 0,4%/ $^{\circ}\text{C}$

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	Tension nominale Rated voltage			
SPT 519-1	470 pF	10 %	1200 V	
	Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance		

CONDENSATEURS CERAMIQUE DE PUISSANCE

POWER CERAMIC CAPACITORS

CAW 54 à/to 65

CEW 54 à/to 65

Appellation commerciale / Commercial type																		
CAW 54	CAW 55	CAW 65	CEW 54	CEW 55	CEW 65	Dimensions / Dimensions (mm)												
Dimensions / Dimensions (mm)												Tolerances sur capacité Tolerance on capacitance						
L max.	10,4	15	22	10,4	15	22												
W max.	11	14	16,5	11	14	16,5												
T max.	5	5	5	5	5	5												
U _{RC} (U _{DC}) ⁽¹⁾	1000	2500	3600	1000	2500	3600	1000	2500	3600	1000	2500	3600	1000	2500	3600			
U _{RA} ⁽²⁾	700	1800	2500	700	1800	2500	700	1800	2500	700	1800	2500	700	1800	2500			
Pq (kVar) ⁽³⁾	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12	E12	E24	
1 pF																± 1 pF (FU)		
1,2																± 0,5 pF (DU)		
1,5																		
1,8																		
2,2																		
2,7																		
3,3																		
3,9																		
4,7																		
5,6																		
6,8																		
8,2																		
10																		
12																		
15																		
18																		
22																		
27																		
33																		
39																		
47																		
56																		
68																		
82																		
100																		
120																		
150																		
180																		
220																		
270																		
330																		
390																		
470																		
560																		
680																		
820																		
1000																		
1200																		
1500																		
1800																		
2200																		
2700																		
3300																		
3900																		
4700																		
5600																		
6800																		
8200																		
10 nF																		
12																		
15																		

(1) Tension nominale U_{RC} (V_{CC} + V crête)

(2) Tension nominale U_{RA} (V eff.)

(3) Puissance réactive nominale Pq (kVar)

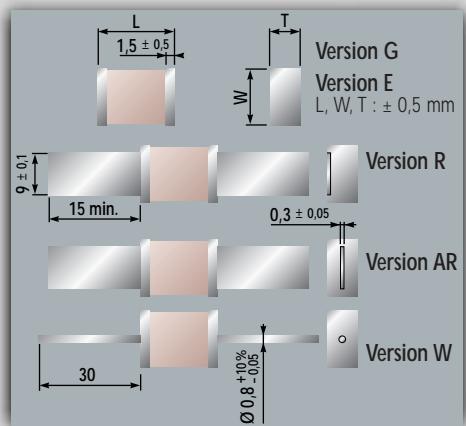
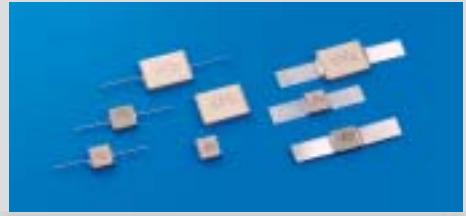
(1) Rated voltage U_{DC} (V_{DC} + V peak)

(2) Rated voltage U_{RA} (V rms)

(3) Reactive rated power Pq (kVar)

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	Version Version	Tension nominale Rated voltage			
CAW 54	AR	560 pF	5 %	2500 V	
		Capacité Capacitance		Tolérance Tolerance	



Diélectrique Céramique haute tension
faible pertes - classe 1

Technologie Chips multicouches
terminaisons soudables
Barrière de nickel + dorure (G)
Barrière de nickel + étamage
à chaud (E)
ou rubans d'argent (R) (AR)
ou fils de cuivre étamés (W)

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES

Température d'utilisation - 55°C + 125°C
Coefficient de température
CAW 100 ± 30 ppm/°C
CEW 0 ± 30 ppm/°C
Tension nominale U_{RC} 1000 V - 3600 V
Tension de tenue 2 U_{RC}
Tangente δ à 1 MHz $\leq \frac{(150 + 7)}{C_R} \cdot 10^{-4}$
 $C_R \leq 50 \text{ pF}$ $\leq 10 \cdot 10^{-4}$
 $50 \text{ pF} < C_R < 1000 \text{ pF}$ $\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tg δ à 1 kHz $C_R \geq 1000 \text{ pF} \leq 10 \cdot 10^{-4}$
Résistance d'isolement
à 20°C sous 500 V_{DC} $\geq 50000 \text{ M}\Omega$

Dielectric Low loss - high voltage
Ceramic class 1

Technology Multilayer chips
weldable terminations
Gold on nickel barrier (G)
Dipped on nickel barrier (E)
or with silver ribbon leads (R) (AR)
or tinned copper leads (W)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Operating temperature - 55°C + 125°C
Temperature coefficient
CAW 100 ± 30 ppm/°C
CEW 0 ± 30 ppm/°C
Rated voltage U_{RC} 1000 V - 3600 V
Test voltage 2 U_{RC}
Tangent δ at 1 MHz $\leq \frac{(150 + 7)}{C_R} \cdot 10^{-4}$
 $C_R \leq 50 \text{ pF}$ $\leq 10 \cdot 10^{-4}$
 $50 \text{ pF} < C_R < 1000 \text{ pF}$ $\leq 10 \cdot 10^{-4}$
Tg δ at 1 kHz $C_R \geq 1000 \text{ pF} \leq 10 \cdot 10^{-4}$
Insulation resistance
at 20°C under 500 V_{DC} $\geq 50000 \text{ M}\Omega$

MARQUAGE

Model
Capacitance - Tolerance
Voltage
Date-code (sur demande)

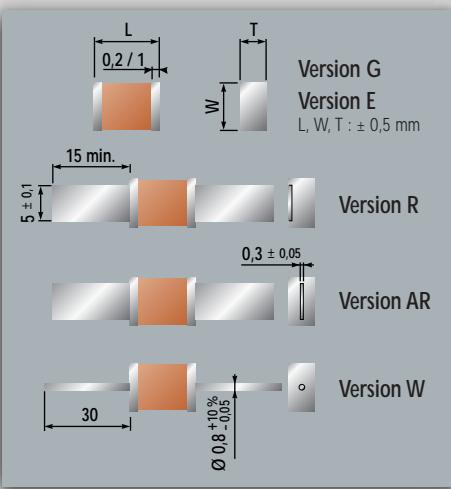
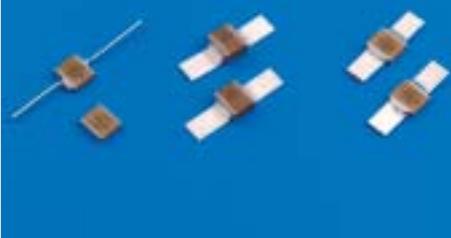
MARKING

Date-code (on request)

Sur demande : modèles vernis
On request : varnished models

CNW 32

**POUR APPLICATION HF et RF
FOR HF and RF APPLICATIONS**



Diélectrique	Céramique faible pertes - classe 2
Technologie	Chips multicouches terminaisons soudables Barrière de nickel + dorure (G) Barrière de nickel + étamage à chaud (E) ou rubans d'argent (R) (AR) ou fils de cuivre étamés (W)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Température d'utilisation	- 55°C + 125°C
Caract. capacité température	X7R
Tension nominale U_{RC}	100 V - 300 V
Tension de tenue	2,5 U_{RC}
$Tg \delta$ à 1 kHz 1 V eff.	$\leq 250.10^{-4}$
Résistance d'isolement sous U_{RC}	$\geq 1000 M\Omega.\mu F$

Dielectric	Low loss - ceramic class 2
Technology	Multilayer chips weldable terminations Gold on nickel barrier (G) Dipped on nickel barrier (E) or with silver ribbon leads (R) (AR) or tinned copper leads (W)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Operating temperature	- 55°C + 125°C
Capacit. temp. characteristic	X7R
Rated voltage U_{RC}	100 V - 300 V
Test voltage	2,5 U_{RC}
$Tg \delta$ at 1 kHz 1 V rms	$\leq 250.10^{-4}$
Insulation resistance under U_{RC}	$\geq 1000 M\Omega.\mu F$

MARQUAGE	MARKING
Modèle	Model
Capacité	Capacitance
Tolérance	Tolerance
Tension	Voltage
Date-code	Date-code

CONDENSATEURS CÉRAMIQUE DE PUISSE

POWER CERAMIC CAPACITORS

Appellation commerciale / Commercial type

CNW 32

Dimensions / Dimensions (mm)

L ± 0,5	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
W ± 0,5	7	7	7	7	7	
T max.	2	2	2	2	2	
a	0,2 / 1	0,2 / 1	0,2 / 1	0,2 / 1	0,2 / 1	

Tension nominale / Rated voltage

U_{RC} (V)	100	150	200	250	300	E6	E12
10 nF						103	
12						123	
15						153	
18						183	
22						223	
27						273	
33						333	
39						393	
47						473	
56						563	
68						683	
82						823	
100						104	$\pm 20\% (M)$
120						124	
150						154	
180						184	
220						224	
270						274	
330						334	
390						394	
470						474	
560						564	
680						684	
820						824	
1 μF						105	

Exemple de codification à la commande / How to order

Appellation commerciale Commercial type	Version Version	Tension nominale Rated voltage		
		CNW 32	R	270 nF
				10 %
				150 V
			Capacité Capacitance	Tolérance Tolerance